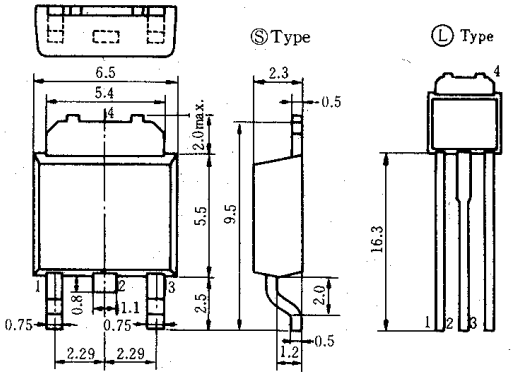
2SK579Ⓛ,2SK580Ⓛ,
2SK579Ⓢ,2SK580Ⓢ

シリコン N チャネル MOS FET

高速度電力スイッチング用

SILICON N-CHANNEL MOS FET

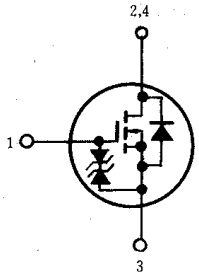
HIGH SPEED POWER SWITCHING



(DPAK)

1. ゲート：Gate
2. ドレイン：Drain
3. ソース：Source
4. ドレイン：Drain

(Dimensions in mm)



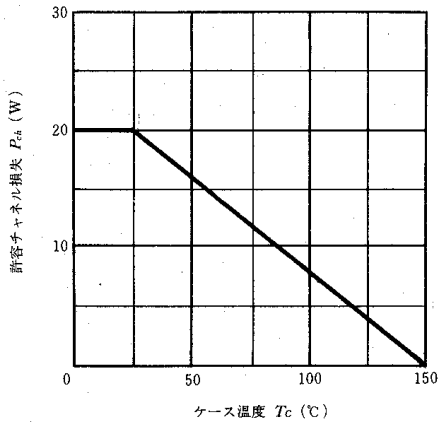
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SK579Ⓛ, 2SK579Ⓢ	2SK580Ⓛ, 2SK580Ⓢ	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DSS}	450	500	V
ゲート・ソース電圧	V_{GSS}	±15	±15	V
ドレイン電流	I_D	1.5	1.5	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(pulse)}$*	6	6	A
逆ドレイン電流	I_{DR}	1.5	1.5	A
許容チャネル損失	P_{ch}**	20	20	W
チャネル温度	T_{ch}	150	150	℃
保存温度	T_{stg}	−55～+150	−55～+150	℃

* パルス幅≦10μs, デューティサイクル≦1%
* PW≦10μs, duty cycle ≦1%
** T_C=25℃における許容値
** Value at T_C=25℃

許容チャネル損失のケース温度による変化

MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	2SK579Ⓛ, 2SK579Ⓢ			2SK580Ⓛ, 2SK580Ⓢ			Unit
			min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DSS}$	I_D=10mA, V_{GS}=0	450	—	—	500	—	—	V
ゲート・ソース破壊電圧	$V_{(BR)GSS}$	I_G=±100μA, V_{DS}=0	±15	—	—	±15	—	—	V
ゲート遮断電流	I_{GSS}	V_{GS}=±12V, V_{DS}=0	—	—	±10	—	—	±10	μA
ドレイン電流	I_{DSS}	V_{DS}=360V, V_{GS}=0	—	—	100	—	—	—	μA
		V_{DS}=400V, V_{GS}=0	—	—	—	—	—	100	
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$	I_D=1mA, V_{DS}=10V	2.0	—	4.0	2.0	—	4.0	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(on)}$	I_D=1A, V_{GS}=10V*	—	3.5	5.5	—	4.0	6.0	Ω
順伝達アドミタンス	$\|y_{fs}\|$	I_D=1A, V_{DS}=20V*	0.6	1.0	—	0.6	1.0	—	S
入力容量	C_{iss}	V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz	—	260	—	—	260	—	pF
出力容量	C_{oss}		—	95	—	—	95	—	pF
逆伝達容量	C_{rss}		—	12	—	—	12	—	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$	I_D=1A, V_{GS}=10V, R_L=30Ω	—	8	—	—	8	—	ns
立ち上がり時間	t_r		—	20	—	—	20	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	28	—	—	28	—	ns
下降時間	t_f		—	20	—	—	20	—	ns
ダイオード順電圧	V_{DF}	I_F=1.5A, V_{GS}=0	—	1.0	—	—	1.0	—	V
逆回復時間	t_{rr}	I_F=1.5A, V_{GS}=0, di_F/dt=100A/μs	—	250	—	—	250	—	ns

* パルス測定
* Pulse Test